

عنوان مقاله:

طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحیه دیفیوژن مشترک در میان هر word line و جفت معکوس کننده

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی مهندسی برق (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

مجتبی سالمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه پیام نور تهران واحد تهران شمال، ایران

سیدجواد جوادی مقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور تهران واحد تهران شمال، ایران

خلاصه مقاله:

تقاضا برای SRAM به دلیل تبدیل شدن آن به جزء اصلی بسیاری از تراشه ها و همچنین کارآرایی بالا در مدارات VLSI، در حال افزایش است و توان مصرفی تبدیل به جز اصلی طراحی تراشه ها شده است. در این مقاله به شبیه سازی و آنالیز سلول 6T SRAM با استفاده از تکنیک پشته کردن جهت کاهش توان مصرفی همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحیه دیفیوژن مشترک در میان هر word line و جفت معکوس کننده پرداخته ایم. معماری مورد نظر با استفاده از نرم افزار Micro wind و با تکنولوژی 0.25 m طراحی و شبیه سازی شده و توان مصرفی و تأخیر در آن مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی:

سلول 6T SRAM، توان مصرفی، VLSI، تأخیر، کارآیی بالا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/503885>

